

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

09/17 44586

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application: 1998年10月13日

出願番号
Application Number: 平成10年特許願第290248号

出願人
Applicant(s): 松下電器産業株式会社

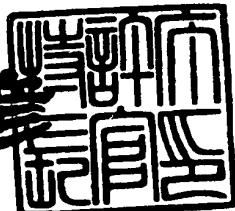
PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年10月 8日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆
(Signature)



出証番号 出証特平11-3067691

【書類名】 特許願
【整理番号】 2036400168
【提出日】 平成10年10月13日
【あて先】 特許庁長官 伊佐山 建志 殿
【国際特許分類】 G02F 1/133
【発明の名称】 反射型液晶表示素子
【請求項の数】 10
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式
会社内
【氏名】 久保田 浩史
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式
会社内
【氏名】 中尾 健次
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式
会社内
【氏名】 上村 強
【特許出願人】
【識別番号】 000005821
【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社
【代理人】
【識別番号】 100101823
【弁理士】
【氏名又は名称】 大前 要
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 039295
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9721050

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 反射型液晶表示素子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板間に、高分子中に液晶滴が分散された高分子分散型液晶層が配置され、前記一対の基板のうちの一方の基板に反射層が形成され、前記高分子分散型液晶層間に電界を印加して、高分子分散型液晶層の光散乱状態を変化させて表示を行なう反射型液晶表示素子において、

前記高分子分散型液晶層の厚みを d (μm)、前記高分子分散型液晶層の散乱ゲインを G とした場合に、

$$50 \exp(-0.4d) < G < 360 \exp(-0.47d)$$

が成立つことを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項2】 前記散乱ゲインが、前記高分子分散型液晶層を透過型パネルに形成した場合の透過光に対する散乱ゲインであることを特徴とする請求項1記載の反射型液晶表示素子。

【請求項3】 前記高分子分散型液晶層の厚み d が、 $3 \mu m$ 以上、 $8 \mu m$ 以下であることを特徴とする請求項1記載の反射型液晶表示素子。

【請求項4】 一対の基板間に、高分子中に液晶滴が分散された高分子分散型液晶層が配置され、前記一対の基板のうちの一方の基板に反射層が形成され、前記高分子分散型液晶層間に電界を印加して、高分子分散型液晶層の光散乱状態を変化させて表示を行なう反射型液晶表示素子において、

液晶の複屈折率と高分子分散型液晶層の厚みの積が、 $0.6 \mu m$ 以上、 $2.2 \mu m$ 以下であることを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項5】 前記液晶滴の粒径が、 $0.7 \mu m$ 以上、 $2 \mu m$ 以下であることを特徴とする請求項4記載の反射型液晶表示素子。

【請求項6】 前記液晶の複屈折率が、 0.15 以上、 0.27 以下であることを特徴とする請求項4記載の反射型液晶表示素子。

【請求項7】 前記高分子分散型液晶層の厚みが、 $3 \mu m$ 以上、 $8 \mu m$ 以下であることを特徴とする請求項4記載の反射型液晶表示素子。

【請求項8】 一対の基板間に、高分子中に液晶滴が分散された高分子分散型

液晶層が配置され、前記一対の基板のうちの一方の基板に反射層が形成され、前記高分子分散型液晶層間に電界を印加して、高分子分散型液晶層の光散乱状態を変化させて表示を行なう反射型液晶表示素子において、

前記液晶滴のうち一対の基板界面近傍に存在する液晶滴が、基板に大円を接するほぼ半球状に形成され、かつ、前記半球状の液晶滴内部の液晶が基板と平行なる方向にほぼ一様に配向していることを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項9】 前記一対の基板のうちの一方の基板界面に形成された前記半球状の液晶滴内部の液晶の配向方位と、前記一対の基板のうちの他方の基板界面に形成された前記半球状の液晶滴内部の液晶の配向方位とは、互いにほぼ平行であることを特徴とする請求項8記載の反射型液晶表示素子。

【請求項10】 前記高分子分散型液晶層の厚みが、3μm以上、8μm以下であることを特徴とする請求項8又は9記載の反射型液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、高輝度、高コントラストな反射型ディスプレイ等に好適に実施することができる反射型の高分子分散型液晶表示素子に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、高分子化合物と液晶組成物を非相溶状態に分散させた高分子分散型の液晶パネルが注目されている。高分子分散型パネルは、散乱モードを表示に用いるため、偏光板が不要で高輝度の表示が容易に得られるという特徴がある (S.Shikama et.al, Society for information Display' 95, Page 231-234)。

【0003】

このような高分子分散型パネルを反射型ディスプレイに適用する例が、特開平8-43849号公報（以下、第1従来例と称する。）及び特開平7-4950号公報（以下、第2従来例と称する。）に開示されている。

【0004】

第1従来例は、液晶パネル背後に光吸収層としての黒色吸収板を設け、ノーマ

リブラックモードで駆動を行うことを特徴とするものである。

【0005】

第2従来例は、反射板を鏡面とし、液晶と複屈折を有する高分子とがパネル内部で互いに配向したリバースモードの高分子分散層を用いて反射型パネルを作成したことを特徴とするものである。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

上記第1従来例では、背後に黒色吸収板を設ける構成のため、散乱状態において表示面側で吸収板の黒色がうつてしまい白輝度が低くなる課題があった。また、第2従来例では、液晶分率がかなり大きいため、高分子のネットワーク構造が脆弱でヒステリシス等の表示不良が起こりやすいという課題があった。

【0007】

本発明は、上記課題を解決し、高コントラスト、高輝度の高分子分散型液晶を使用した反射型液晶素子を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、上記課題を解決すべく、銳意研究開発した結果、ノーマリホワイトモードの反射型の高分子分散型液晶表示素子の電圧・反射率特性においてピーク値が存在することを見出した（図3参照）。従って、このピーク値を白輝度とすることで、高輝度化と高コントラスト化を図ることができる。

【0009】

更に、このピーク値が高分子分散型液晶層の散乱ゲインと相関関係にあり、より大きなピーク値を得るためにには最適な散乱ゲインの範囲があることを見出した（図5参照）。更に、散乱ゲインはパネルギャップ、液晶滴の粒径、及び液晶の屈折率異方性の大きさにより決定されるものであるから、これらパネルギャップ、液晶滴の粒径、及び液晶の屈折率異方性についても最適値が存在することが認められる。そこで、最適な散乱ゲインの範囲を得るためにパネルギャップ、液晶滴の粒径、及び液晶の屈折率異方性の範囲を見出した。

【0010】

本発明、上記の現象及び事実に基づき完成したものである。具体的な構成は、以下の通りである。

[0 0 1 1]

〔0011〕
本発明のうちの請求項1記載の発明は、一对の基板間に、高分子中に液晶滴が分散された高分子分散型液晶層が配置され、前記一对の基板のうちの一方の基板に反射層が形成され、前記高分子分散型液晶層間に電界を印加して、高分子分散型液晶層の光散乱状態を変化させて表示を行なう反射型液晶表示素子において、前記高分子分散型液晶層の厚みを d (μm)、前記高分子分散型液晶層の散乱ゲインを G とした場合に、

$$50 \exp(-0.4d) < G < 360 \exp(-0.47d)$$

が成立つことを特徴とする。

[0012]

散乱ゲインとコントラストとの間には、図5に示す相関関係がある。この図5から明らかなように高分子分散型液晶層の厚み（パネルギャップに相当する。）d毎に、最大コントラストとなる散乱ゲインが存在する。そこで、図5において、最大コントラストの70%以上の範囲を設定範囲とした場合に、図6に示すパネルギャップdと散乱ゲインとの関係が得られる。図6において、ラインP1は散乱ゲインの許容範囲の上限を示し、ラインP3は散乱ゲインの許容範囲の下限を示している。よって、このラインP1とラインP3との範囲内で散乱ゲインを設定すれば、最大コントラストの70%以上のコントラストが得られることになる。ここで、ラインP1は $G = 360 \exp(-0.47d)$ であり、ラインP3は $G = 50 \exp(-0.4d)$ である。よって、高分子分散型液晶層の散乱ゲインGが、

$$5.0 \exp(-0.4d) < G < 360 \exp(-0.47d)$$

を満たすように作製しておけば、最大コントラストの70%以上のコントラストが得られ、高輝度及び高コントラストの反射型の高分子分散型液晶表示素子が実現される。

[0013]

尚、「反射層」は、反射性を有する金属から成る反射画素電極により反射層と

電極を兼用した構成であってもよく、また、画素電極として透明電極を使用し、反射層は別途基板に形成するようにしてもよい。

【0014】

また本発明のうちの請求項2記載の発明は、請求項1記載の反射型液晶表示素子であって、散乱ゲインが、高分子分散型液晶層を透過型パネルに形成した場合の透過光に対する散乱ゲインであることを特徴とする。

【0015】

また本発明のうちの請求項3記載の発明は、請求項1記載の反射型液晶表示素子であって、高分子分散型液晶層の厚みdが、3μm以上、8μm以下であることを特徴とする。

【0016】

高分子分散型液晶層の厚みdを規制するのは、以下の理由による。厚みdが3μm未満であれば、均一に作ることが困難であり、厚みdが8μmを超えると駆動電圧が大き過ぎることになるからである。

【0017】

本発明のうちの請求項4記載の発明は、一対の基板間に、高分子中に液晶滴が分散された高分子分散型液晶層が配置され、前記一対の基板のうちの一方の基板に反射層が形成され、前記高分子分散型液晶層間に電界を印加して、高分子分散型液晶層の光散乱状態を変化させて表示を行なう反射型液晶表示素子において、液晶の複屈折率と高分子分散型液晶層の厚みの積が、0.6μm以上、2.2μm以下であることを特徴とする。

【0018】

散乱ゲインは、高分子分散型液晶層の厚みd、液晶の複屈折率の大きさ△n、及び液晶滴の粒径等により決定される。本発明者の実験結果によれば、△ndとコントラストとの間には、図8に示す相関関係があることが認められた。この図8により、コントラスト30以上を設定範囲すると、△ndは0.6μm以上、2.2μm以下の範囲となる。従来の反射型液晶表示素子のコントラストは10程度であるため、コントラスト30以上を設定範囲とすれば、従来例に比べて格段に高コントラスト化が図れる。

[0019]

【0019】
本発明のうちの請求項5記載の発明は、請求項4記載の反射型液晶表示素子であつて、液晶滴の粒径が、0.7μm以上、2μm以下であることを特徴とする。

[0020]

〔0020〕
本発明のうちの請求項6記載の発明は、請求項4記載の反射型液晶表示素子であって、液晶の複屈折率が、0.15以上、0.27以下であることを特徴とする。

[0021]

【0021】
本発明のうちの請求項7記載の発明は、請求項4記載の反射型液晶表示素子であって、高分子分散型液晶層の厚みが、 $3\text{ }\mu\text{m}$ 以上、 $8\text{ }\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする。

[0022]

【0022】
本発明のうちの請求項8記載の発明は、一对の基板間に、高分子中に液晶滴が分散された高分子分散型液晶層が配置され、前記一对の基板のうちの一方の基板に反射層が形成され、前記高分子分散型液晶層間に電界を印加して、高分子分散型液晶層の光散乱状態を変化させて表示を行なう反射型液晶表示素子において、前記液晶滴のうち一对の基板界面近傍に存在する液晶滴が、基板に大円を接する半球状に形成され、かつ、前記半球状の液晶滴内部の液晶が基板と平行な方向にほぼ一様に配向していることを特徴とする。

[0023]

【0023】 基板界面の液晶滴内部の液晶分子が、基板に平行な方向にほぼ一様に配列して
いるので、界面層での散乱が低減し、散乱ゲインが大きくなる。よって、この半
球状の大きさを調整することにより、散乱ゲインを最適に値に制御するこ
とができる。即ち、基板界面の液晶を同一の方向に配向させることで、液晶組成、液晶
滴の粒径等を変えずにパネルの散乱ゲインを最適範囲に調整することが可能とな
る。

[0024]

【0024】
本発明のうちの請求項9記載の発明は、請求項8記載の反射型液晶表示素子で

あって、一対の基板のうちの一方の基板界面に形成された前記半球状の液晶滴内部の液晶の配向方位と、前記一対の基板のうちの他方の基板界面に形成された前記半球状の液晶滴内部の液晶の配向方位とは、互いにほぼ平行であることを特徴とする。

【0025】

上記構成により、一対の基板界面間での散乱ゲインが更に低減する作用がある

【0026】

本発明のうちの請求項10記載の発明は、請求項8記載の反射型液晶表示素子であって、前記高分子分散型液晶層の厚みが、3μm以上、8μm以下であることを特徴とする。

【0027】

高分子分散型液晶層の厚みを規制するのは、上記請求項3記載の発明において説明したのと同様の理由による。

【0028】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。

(実施の形態1)

図1は本発明の実施の形態1に係る液晶表示素子1の簡略化した断面図である。液晶表示素子1は、反射型の液晶表示素子であり、ノーマリホワイトモードの液晶表示素子である。液晶表示素子1は、アレイ基板2と、アレイ基板2に対向して配置される対向基板3と、アレイ基板2と対向基板3との間に配置された高分子分散型液晶層4とを有する。アレイ基板2及び対向基板3は、例えばガラスから成る透明な基板である。このアレイ基板2上には、ソースライン6、反射性を有する金属から成る反射画素電極5、及び画素スイッチング素子としての薄膜トランジスタ(TFT)等が形成されている。反射画素電極5は、アルミニウム(A1)あるいはクロム(Cr)等から成る。これらソースライン6、反射画素電極5及びTFT等は、絶縁膜7により覆われている。前記対向基板3の内側面には、RGBカラーフィルタ8と、透明な対向電極9と、絶縁膜10とがこの順

序で積層状に形成されている。

[0029]

【0029】 また前記高分子分散型液晶層4は、高分子11中に液晶滴12が分散された構造とされ、液晶滴12内の液晶は誘電率異方性が正のものが用いられている。

[0030]

【0030】 ここで、高分子分散型液晶層4は、その散乱ゲインGが、以下の第1式の関係を満たしている。ここで、散乱ゲインGは、 $G = (\text{パネル輝度} / \text{パネル照度}) \times \pi$ で定義されるものであり、散乱ゲインが大きいと散乱性が小さく、散乱ゲインが小さいと散乱性が大きいことを意味する。

[0031]

50 \exp(-0.4d) < G < 360 \exp(-0.47d) \dots (1)

d は高分子分散型液晶層 4 の層厚 (以下、パネルギャップと称する。) である。

[0032]

【0032】
上記のように高分子分散型液晶層4の散乱ゲインが第1式を満たすように設定することにより、従来例に比べて格段に高輝度及び高コントラストの反射型液晶表示素子を実現できる。

[0033]

以下に、本発明に係る液晶表示素子の動作を説明しつつ、上記の理由を述べることにする。

[0034]

れて正反射光22としてパネルから放出される。このとき、観察者25の方向には光が放出されずパネルは黒表示が得られる。

【0035】

ところで、上記表示動作を有する高分子分散型液晶表示素子の電圧・反射率特性は、図3に示されている。この図3の特性は、本発明者の実験結果により得られたものである。尚、測定条件は、入射光の入射角度 $\theta_1 = 30^\circ$ 、測定角度 $\theta_2 = 15^\circ$ （図2（b）参照）とした。この測定条件は、反射型液晶表示素子の標準の見方に対応させたものである。

【0036】

図3から明らかなように、印加電圧の増加に従い、反射率は上昇していきピーク値に達した後、減少する。即ち、反射型の高分子分散型液晶表示素子は、その電圧・反射率特性においてピーク反射率が存在する。このようなピーク反射率の存在は、本発明者の実験結果により初めて見出されたものである。

【0037】

ここで、ピーク反射率が存在するのは、以下の原理によると考えられる。図4を参照して、その原理を説明する。図4において、電圧無印加時（図3のA点に相当）のパネルの散乱状況を散乱波形30で示し、反射率が最大となるとき（図3のB点に相当）の散乱状況を散乱波形31で示し、さらに電圧を印加した場合（図3のC点に相当）の散乱状況を散乱波形32で示した。ノーマリホワイトモードの高分子分散型パネルの場合、電圧印加に伴い散乱は弱くなり入射光の正反射方向に散乱波形が伸びる。このとき、図4の観察者25の位置からは、散乱波形30より散乱波形31の方が反射率が高い。また、さらに電圧を印加すると、ほぼ正反射方向に収束した散乱波形32となり、観察者25方向の反射率は減少する。このため電圧・反射率特性の反射率にピークが発生する。本発明者は、かかる電圧・反射率特性に着目して、ピーク反射率での輝度レベルを白輝度とすることで、高輝度化及び高コントラスト化を図ることを見出した。

【0038】

なお、従来、電圧・反射率特性においてピーク反射率の存在は知られていなかった。これは、斜め方向からの入射光に対して、パネル正面に反射する光を測定

して、電圧・反射率特性を得ていたこと、更には、透過型の場合に散乱ゲイン G は 1 ~ 2 度に設定されていたことから、反射型についても散乱ゲインは同程度の散乱ゲインのものが使用されており、そのためピーク反射率が小さく、ピーク反射率の存在が認識されていなかったものと考えられる。

[0039]

ここで、図3を参照して、散乱ゲインと電圧・反射率特性の関係について説明する。従来の黒色吸収板を用いる反射型の液晶表示素子では、散乱ゲインGは1～2程度である。これは、一般に透過型液晶表示素子においては、散乱状態（初期状態）において完全散乱を得るために、G=1程度に設定されており、反射型の液晶表示素子においても、完全散乱を得ることにより高輝度及び高コントラストが実現できものとの考えにより、散乱ゲインがG=1程度に設定されているのが実情である。ところが、本発明者の実験結果によれば、上記したように電圧・反射率特性において、ピーク反射率（ピーク輝度に相当）が存在しており、G=1の場合の電圧・反射率特性は、図3のラインM1で示される。従って、G=1に設定されている従来例では、実際には、電圧無印加状態（印加電圧0Vの場合）よりも、輝度レベルが大きい場合が存在する。なお、G=1の場合、液晶分子が基板に対して垂直状態となつても、斜め光については、高分子と液晶の屈折率が異なることから、反射率が0%からかなり離れた値に収束する。このような状態であつても、黒色吸収板を用いるので、黒レベルでは黒色吸収板の黒が写るのとで、反射率は0%でなくても十分な黒レベルが得られる。しかしながら、コントラストが高くない。

[0040]

一方、 $G = 100$ の場合の電圧・反射率特性は、図 3 のライン M2 で示される。即ち、電圧增加に従って、反射率は初期状態から若干上昇した後、減少していく。ほぼ 0% に収束する。これは、散乱ゲインが大きい場合（即ち、散乱性が小さい場合）には、斜めからの光に対しても散乱性の変化は小さいと考えられる。従って、ピーク反射率も小さくなると考えられる。一方、散乱性が本来的に小さいので、電圧上昇により反射率がほぼ 0% に収束する。こうして、散乱ゲインは小さくても、大きすぎても、高輝度及び高コントラストが得られない。高輝度化

及び高コントラスト化を達成するためには、最適な散乱ゲインが存在することが認められる。本発明者の実験結果によれば、約20~30程度の散乱ゲインが最適値である。従って、そのような最適な散乱ゲインに設定することにより、図3のラインM3で示される特性が得られ、高輝度化及び高コントラスト化を達成できる。

【0041】

一方、散乱ゲインは、パネルギャップと相関関係があり、最適な散乱ゲインを得るためにパネルギャップの値を考慮する必要がある。そこで、具体的に最適な散乱ゲインを求めるため、様々な散乱性能を有する高分子分散型液晶パネルの評価を行い、その結果、図5に示す散乱ゲインとコントラストとの関係を得た。なお、散乱ゲインは、透過型パネルで測定した散乱ゲインを用いた。また、コントラストは上記電圧・反射率特性の場合と同様の測定条件（入射光の入射角度 $\theta_1 = 30^\circ$ 、測定角度 $\theta_2 = 15^\circ$ ）で測定した結果を用いた。図5から明らかなように、コントラストが最大となる散乱ゲインが存在し、しかも該散乱ゲインはパネルギャップで異なることが認められる。このことは、パネルギャップを或る値に設定すれば、最大コントラストを得るために散乱ゲインが決定されることを意味する。ここで、本発明に係る液晶表示素子としては、最大コントラストの70%以上のコントラストが得られれば充分であるので、最大コントラストの70%以上のコントラストを得る散乱ゲインの範囲を求ることにした。尚、従来例の反射型パネルのコントラストは、通常10程度であり、大きい場合でも15程度である。従って、最大コントラストの70%以上であれば、従来例に比べて格段に高コントラスト化が実現できることになる。

【0042】

最大コントラストの70%以上のコントラストを得る散乱ゲインの範囲は、具体的には以下の手順で求めた。即ち、各パネルギャップdに関する散乱ゲイン-コントラスト特性（図5において、d = 4.5 μmの場合の特性を参照符号L1で、d = 7 μmの場合の特性を参照符号L2で、d = 10 μmの場合の特性を参照符号L3で示している。）において、最大コントラストの70%のコントラスト（図5においてラインm1、m2、m3がd = 4.5 μm、7 μm、10 μm

の場合の最大コントラストの70%のラインを示している)を得る散乱ゲインを求める、この値を順次プロットすることにより図6に示すパネルギャップと散乱ゲインとの関係を得た。具体的に説明すれば、図5の点A1, A2, A3; B1, B2, B3; C1, C2, C3を図6にプロットした。次いで、図6のパネルギャップと散乱ゲインとの関係から最適な散乱ゲインの範囲を算出した。

【0043】

ここで、図6のラインP1は許容範囲上限を示し、ラインP2は最適コントラストの範囲を示し、ラインP3は許容範囲下限を示す。従って、図6の特性より、最適な散乱ゲインGの範囲は、ラインP1とラインP3の範囲にあればよいことが認められる。ここで、ラインP1を関数表示すれば、 $G = 360 \exp(-0.47d)$ であり、ラインP3を関数表示すれば、 $G = 50 \exp(-0.4d)$ である。よって、最適な散乱ゲインGの範囲は、

$$50 \exp(-0.4d) < G < 360 \exp(-0.47d)$$

を満たせばよいことが理解される。

【0044】

なお、ラインP2を関数表示すれば、 $G = 265 \exp(-0.5d)$ である。よって、散乱ゲインGを $265 \exp(-0.5d)$ に設定すれば、最大コントラストが得られることになる。

【0045】

また、本発明者の実験により、最大コントラストとパネルギャップとの間には、図7に示す関係があることが認められた。この図7より、パネルギャップが小さいほど最大コントラストは高い。しかしながら、パネルギャップが $3 \mu m$ 未満の場合には、実際に均一に作製することが困難である。一方、パネルギャップが $8 \mu m$ を超えると、駆動電圧が増加するため、反射型パネルとしては不適切である。よって、パネルギャップdは $3 \mu m$ 以上、 $8 \mu m$ 以下に設定するのが望ましい。

【0046】

(実施の形態2)

実施の形態2に係る液晶表示素子は、基本的には実施の形態1とほぼ同様の構

成を有する。但し、液晶滴内の液晶の屈折率異方性の大きさ Δn とパネルギャップ d の積 $\Delta n d$ が、0.6 μm以上、2.2 μm以下とすることを特徴とする。このような構成によってもまた、高輝度及び高コントラストの反射型の高分子分散型液晶表示素子を実現できる。

【0047】

以下に、その理由について説明する。散乱ゲインは、液晶の屈折率異方性の大きさ、パネルギャップ、及び液晶滴の粒径等により決定される。従って、液晶の屈折率異方性の大きさ Δn とパネルギャップ d の積 $\Delta n d$ により、散乱ゲインを規定することができる。このような考えの下、本発明者の実験により、図8に示す $\Delta n d$ とコントラストとの関係が得られた。ここで、実施の形態2では、30以上のコントラストに設定した。図8において、30以上のコントラストの範囲に対応する $\Delta n d$ は、0.6 μm以上、2.2 μm以下であることが認められる。よって、 $\Delta n d$ が、0.6 μm以上、2.2 μm以下となるように、液晶材料の選択及びパネルギャップの設定により、高輝度及び高コントラストの反射型の高分子分散型液晶表示素子を実現できることになる。

【0048】

なお、パネルギャップ d は、実施の形態1と同様な理由により、3 μm以上、8 μm以下とするのが望ましい。また、液晶の屈折率異方性 Δn は、0.15以上、0.27以下とするのが望ましく、液晶滴の粒径は、0.7 μm以上、2 μm以下とするのが望ましい。尚、パネルギャップ d 、液晶の屈折率異方性 Δn 及び液晶滴の粒径は、上記のそれぞれの範囲内で適宜選択して組み合わせて、 $\Delta n d$ を0.6 μm以上、2.2 μm以下の範囲内に設定すればよい。

【0049】

(実施の形態3)

図9は本発明の実施の形態3に係わる液晶表示素子1Bの簡略化した断面図である。本実施の形態3において、実施の形態1に対応する部分には同一の参照符号を付して説明は省略する。本実施の形態3では、高分子分散型液晶層4Aが、高分子11と、2種類の液晶滴12A、12Bとから構成されている。液晶滴12Aは高分子分散型液晶層4A内部に存在し、実施の形態1の高分子分散型液晶

における液晶滴12と同様な形状である。一方、液晶滴12Bは基板2、3界面にはほぼ半球状に存在する。液晶滴12B内の液晶は、基板2、3に沿ってほぼ一様の方向に配向し、液晶滴12A内の液晶は、液晶の配向軸が3次元的にランダムな方向に配向している。

【0050】

なお、液晶滴12Bを形成すべく、基板2、3上には、配向膜40、41が形成されており、この配向膜40、41に対する濡れ性が、液晶材料の方が高分子材料よりも大きくなるように材料が選定されている。また、配向膜40、41は、ラビング処理により水平配向処理がなされている。

【0051】

上記構成の如く、液晶滴12Bを形成することにより、基板界面層での散乱が低減して、散乱ゲインを大きくする作用が生じる。よって、液晶滴12Bの大きさを調整することにより、液晶組成や液晶滴の粒径等を変えずにパネルの散乱ゲインを最適範囲に調整して、高輝度化及び高コントラスト化を図ることができる。

【0052】

尚、配向膜40と配向膜41のラビング方向は、同一方向としてもよく、また相互に異なる方向としてもよい。但し、同一方向とすれば、基板2、3の各界面間での散乱がさらに低減する効果がある。またパネルギャップdは、3μm以上、8μm以下とする。これは、実施の形態1においてパネルギャップdを規制したのと同様の理由による。

【0053】

【実施例】

(実施例1)

実施例1は実施の形態1に対応するものである。図1に示す液晶表示素子1を以下のように作製した。ガラスから成る透明基板上に、TFT素子、ソースライン6、アルミニウムから成る反射画素電極5等を形成してアレイ基板2とした。このとき、反射画素電極5は平坦な鏡面反射板とした。また、対向基板3上にカラーフィルタ8、透明電極9等を形成した。次いで、上下の基板2、3をパネル

ギャップ $5 \mu\text{m}$ で貼り合わせた。次に基板 2, 3 間に高分子分散型液晶材料（商品名：PNM 201、大日本インキ化学工業製）を真空注入した。そして、高分子分散型液晶材料が真空注入されたパネルに、紫外線を照射し材料を重合させて高分子分散型液晶パネルを作成した。

【0054】

形成したパネルの電圧・反射率特性を測定しパネル評価を行った。これにより図 3 の特性が得られた。次に液晶粒径とパネルギャップを変えたパネルを多数作成し、散乱ゲインとコントラストの関係を評価した。これにより図 5 の特性が得られた。なお、このとき反射型パネルの場合と同材料を用いて、同粒径、同パネルギャップの高分子分散液晶層を透過型パネルで別途作成し、散乱ゲインをパネル透過光から評価した。ここで、コントラストは極角 30° 方向から光を入射したときの極角 15° 方向のピーク反射率の値と最大印加電圧時の輝度から求めた。

【0055】

また、図 5 から図 6 に示す最適な散乱ゲインの範囲とパネルギャップの関係を得た。このときの最適範囲は、最大コントラストの 70 % 以上が実現できる範囲である。図 5 より散乱ゲイン G が、

$$50 \exp(-0.4d) < G < 360 \exp(-0.47d)$$

を満たすときに高コントラストが得られることが解る。このときの d (μm) はパネルギャップである。また、 $G = 265 \exp(-0.5d)$ を満たすとコントラストを最大とすることができます。具体的には、パネルギャップが $4.5 \mu\text{m}$ の場合、最適な散乱ゲインは $10 \sim 40$ 程度の範囲に存在する。またゲイン 25 でコントラストは最大 55 程度が得られた。また、図 7 に示すようにコントラストの最大値はパネルギャップで異なり、 $3 \mu\text{m}$ 以上、 $8 \mu\text{m}$ 以下であればコントラスト 30 以上と極めて良好な表示が得られる。

【0056】

（実施例 2）

実施の形態 1 とほぼ同様の構成において、液晶の屈折率異方性の大きさ Δn 、パネルギャップ d 、及び液晶滴の粒径 R が異なるパネルを多数作成し、電圧・反

射率特性を測定した。特性は、極角30°から光を入射し、極角15°の反射光を測定した。測定結果により、図8に示すパネルコントラストと積△ndの相関が得られた。図8から明らかなようにコントラストは△ndに対しピーク値を有した。また、△ndが、0.6μm以上、2.2μm以下のときにコントラストは30以上となり良好な表示が得られた。このときの液晶の複屈折率は0.15以上、0.27以下とした。また、パネルギャップを、3μm以上、8μm以下とするためには、散乱性の観点から液晶滴の粒径は0.7μm以上、2μm以下とする必要があった。液晶の屈折率異方性と、パネルギャップ、及び粒径の組み合わせは、上記の範囲で任意の組み合わせを取れる。特に駆動電圧の低減の観点からパネルギャップを8μm以下に設定する場合、液晶滴の粒径は0.5μm以上、2μm以下とする必要がある。

【0057】

(実施例3)

実施の形態3に対応する実施例である。実施の形態3に係る液晶表示素子1Bを、以下の方法で作製した。先ず、ガラスから成る透明基板上に、TFT素子、ソースライン6、アルミニウムから成る反射画素電極5等を形成してアレイ基板2とした。このとき、反射画素電極5は平坦な鏡面反射板とした。また、対向基板3上にカラーフィルタ8、透明電極9等を形成した。次に上下の基板2、3に配向膜40、41(商品名:AL5417、日本合成ゴム製)を形成した後、配向膜40、41にラビング処理を施した。ラビング処理の方向は、上下の基板2、3を貼り合わせた後に互いに平行になるようにした。次に、上下の基板2、3を貼り合わせた後に、パネルギャップ5μmで貼り合わせた。次に基板2、3間に高分子分散型液晶をパネルギャップ5μmで貼り合わせた。次に基板2、3間に高分子分散型パネルを作成した。また、実施例3に係る高分子分散型パネルとは別に、配向膜40、41を形成しないこと以外は上記と同様にして評価用の高分子分散型パネルを作成した。本評価パネルの散乱ゲインは30であり、ラビング処理を施さない場合の15より大きかった。また、評価用のパネルの基板を剥離し、画像処理装置を用いて界面を観察したところ界面には半球状の液晶滴が形成されていた。この

ようにラビング処理を施した基板を用いてパネルを作成することで、界面の液晶がラビング方向に沿ってほぼ一様に配向し、界面での散乱を低減することができる。これにより、散乱ゲインを任意に調整することが可能となり、散乱ゲインを高コントラストが実現できる25近辺に設定できる。

【0058】

尚、基板に形成する配向膜は上記以外でも良く、高分子／液晶の相分離時に、基板上に液晶滴が半球状に析出するものなら良い。このとき、配向膜に対する濡れ性を、液晶材料の方が高分子材料より大きくすれば良い。また、ラビング方向は任意で良いが、上下基板の方向を合わせた方が散乱が小さくなる。これは散乱度に応じて上下で方向を変えて良い。

【0059】

(その他の事項)

本発明に係る液晶表示素子は、液晶滴が高分子中にはほぼ独立して存在する形状に限定されるものではなく、互いの一部が繋がった形状でも良い。また、3次元ポリマーネットワークに液晶が挟持された構造でも良い。高分子分散型液晶層は、誘電率異方性が正の液晶を用いたノーマリモードの散乱表示モードであれば材料を問わない。反射層としての反射画素電極はアルミ以外でも良く、クロム等を用いても良く、導電層を設けた誘電多層膜反射板でも良い。更に、また反射画素電極は平坦状であっても良く、また回折格子や鋸歯形状等の微細構造が形成されても良い。このような構造があると、周囲光の映り込み抑制に効果がある。また、上記実施の形態1～3では反射画素電極をソースライン等と同一平面上に作成したが、これは、パシベーション層等を積層した上に反射画素電極を形成しても良い。このとき、パシベーション層を介して反射画素電極をソース、及びゲート上にも作成することで画素開口率が向上し、高輝度化の効果がある。

【0060】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、高分子分散型液晶層の散乱ゲイン、パネルギャップ、及び $\Delta n d$ 等を制御することで、高コントラスト、及び高輝度な反射型の高分子分散型液晶表示素子を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態1に係る液晶表示素子1Aの簡略化した断面図である。

【図2】

液晶表示素子1Aの表示原理を説明するための図である。

【図3】

液晶表示素子1Aの電圧・反射率特性を示す図である。

【図4】

液晶表示素子1Aの散乱特性を示す図である。

【図5】

散乱ゲインとコントラストの関係を示す図である。

【図6】

最適な散乱ゲインの範囲とパネルギャップの関係を示す図である。

【図7】

パネルギャップと最大コントラストの関係を示す図である。

【図8】

パネルコントラストと積 $\Delta n d$ の関係を示す図である。

【図9】

本発明の実施の形態3に係る液晶表示素子1Bの簡略化した断面図である。

【符号の説明】

1A, 1B : 反射型の高分子分散型液晶表示素子

2 : アレイ基板

3 : 対向基板

4, 4A : 高分子分散型液晶層

5 : 反射画素電極

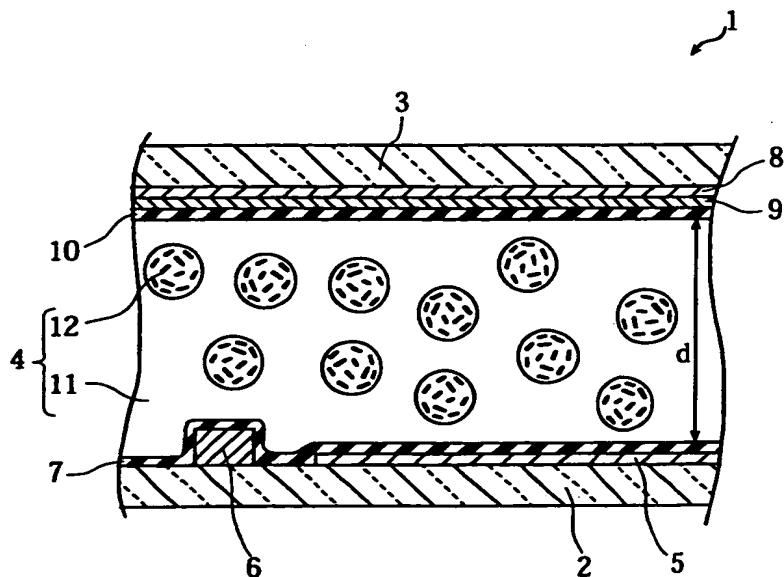
11 : 高分子

12, 12A, 12B : 液晶滴

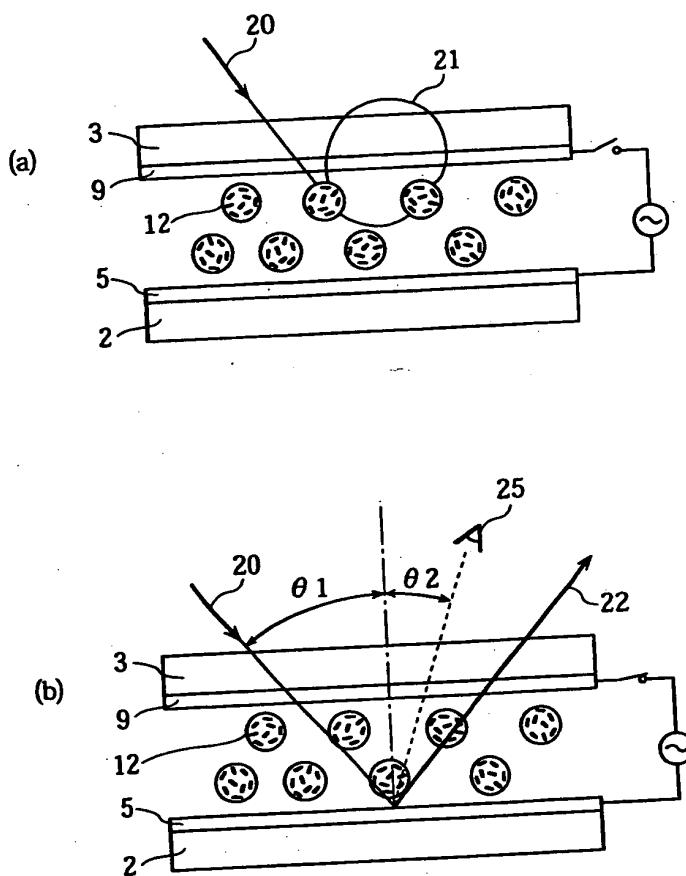
40, 41 : 配向膜

【書類名】 **図面**

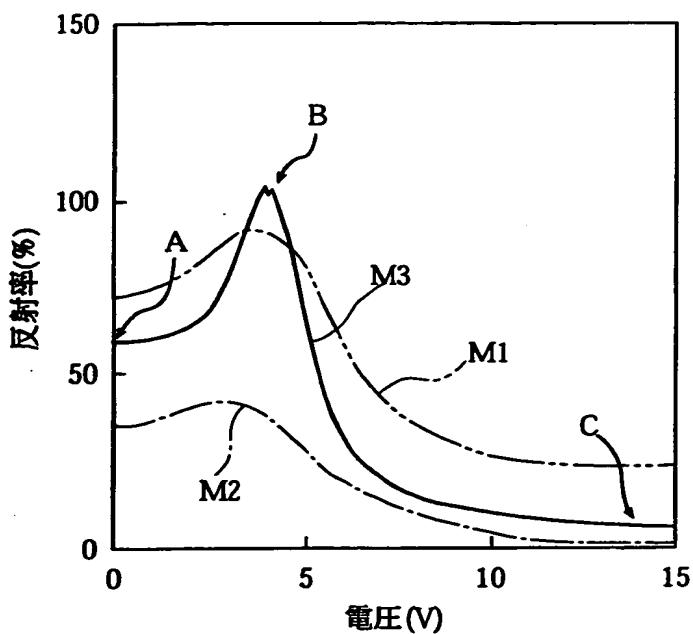
【図1】



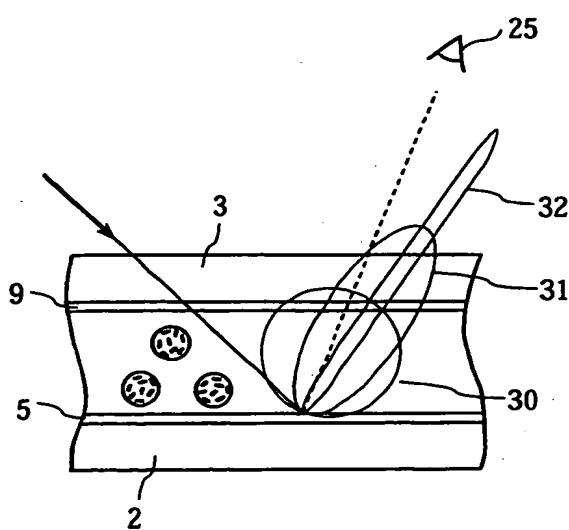
【図2】



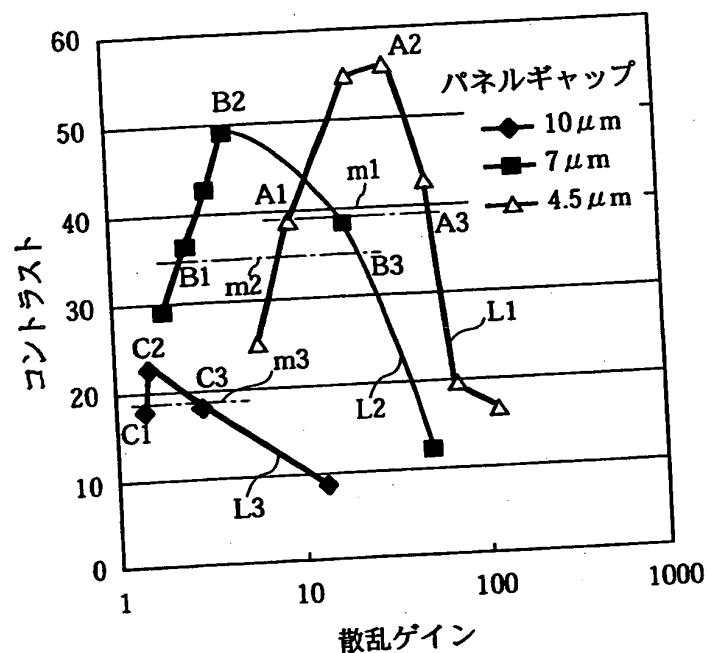
【図3】



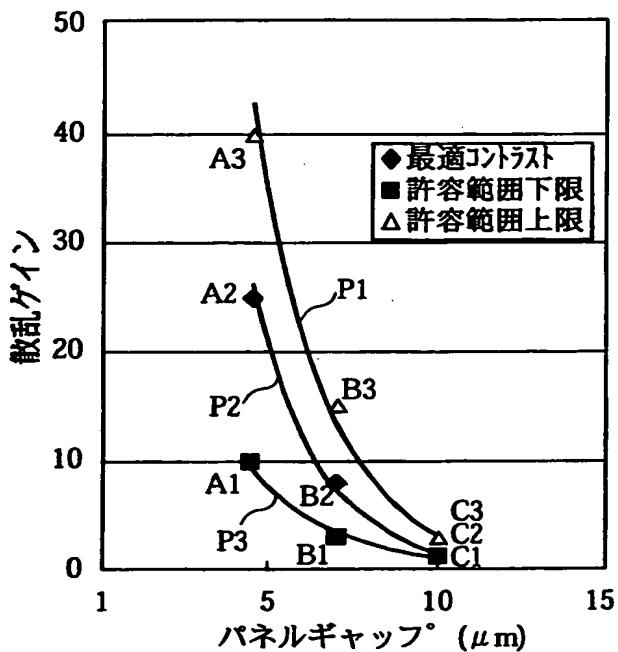
【図4】



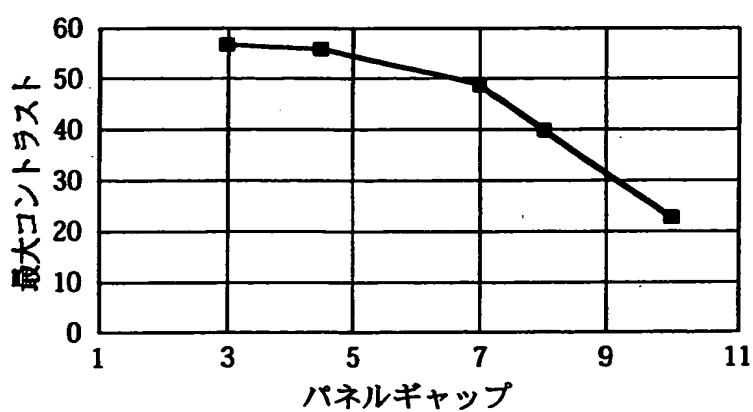
【図5】



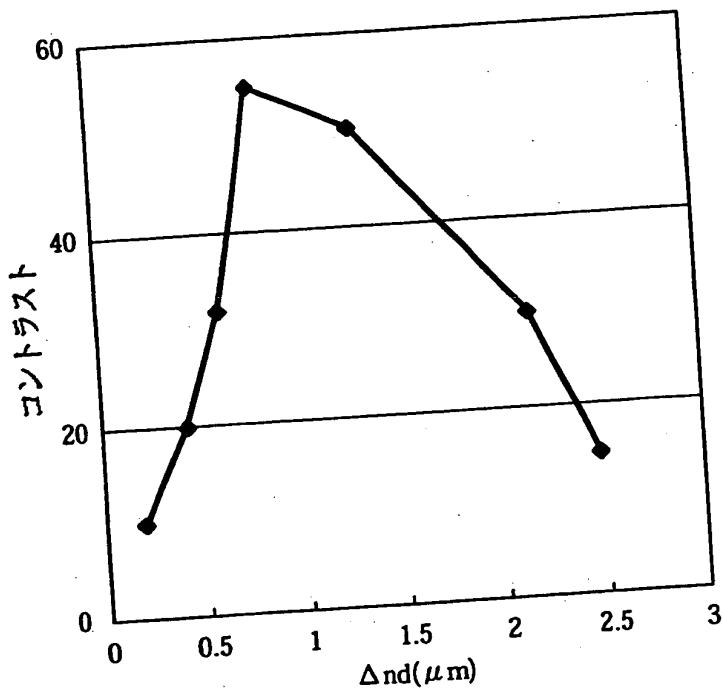
【図6】



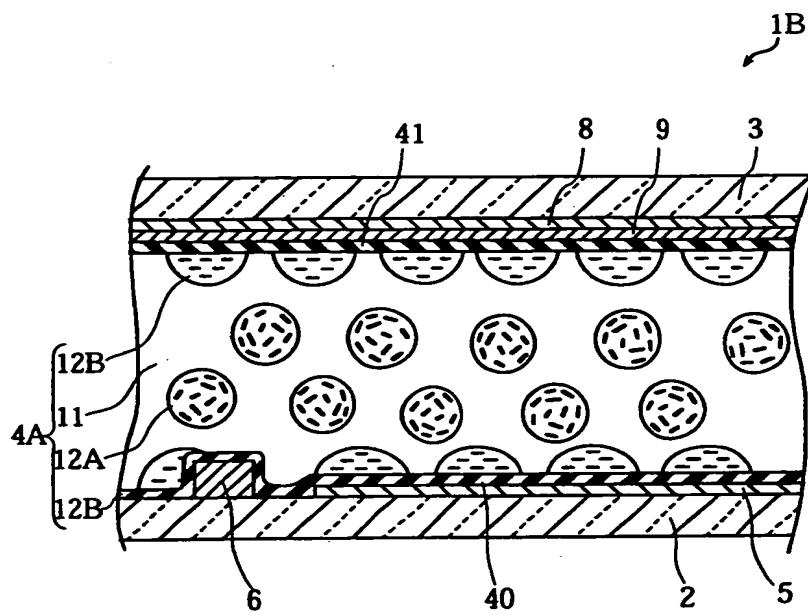
【図7】



【図8】



【図9】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 高輝度と高コントラストを実現し、表示品位に優れた反射型の高分子分散型液晶表示素子を提供する。

【解決手段】 高分子11中に液晶滴12が分散された高分子分散型液晶層4と反射画素電極5を有する反射型の高分子分散型液晶表示素子において、高分子分散型液晶層4の厚みを d (μm)、高分子分散型液晶層4の散乱ゲインをGとした場合に、 $50 \exp(-0.4d) < G < 360 \exp(-0.47d)$ が成立つ。

【選択図】図1

【書類名】 職権訂正データ
【訂正書類】 特許願

〈認定情報・付加情報〉

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100101823

【住所又は居所】 大阪市中央区内平野町2-3-14 ライオンズビル大手前2F 大前国際特許事務所

【氏名又は名称】 大前 要

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社

THIS PAGE BLANK (USPTO)